

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПЕРЕХОДА АНТИФЕРРОМАГНИТНОГО $Mn_{0,5}Zn_{0,5}F_2$



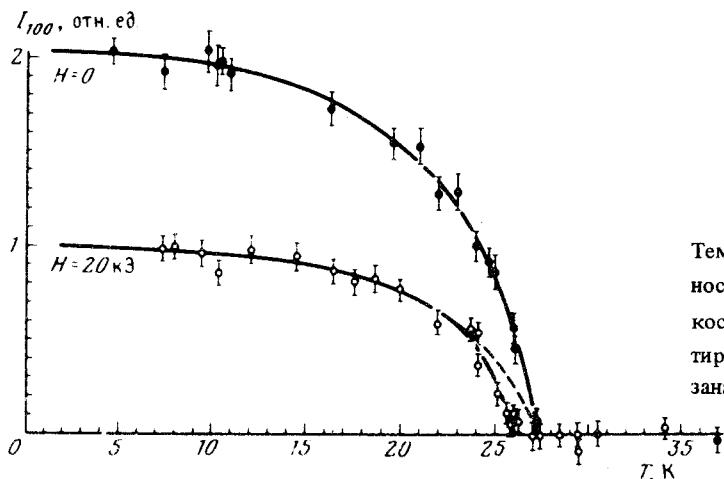
А.В.Дробинин, Ю.М.Ципенюк

Методом дифракции нейтронов исследовалась температурная зависимость интенсивности магнитного рассеяния от плоскостей (100) кристалла $Mn_{0,5}Zn_{0,5}F_2$ в отсутствии поля и в магнитном поле, параллельном оси легкого намагничивания. В поле $H = 20$ кЭ температура перехода уменьшается на величину $1,3 \pm 0,3$ К, что, по-видимому, является проявлением эффекта хаотического магнитного поля:

В последнее время значительно возрос интерес как к теоретическому, так и экспериментальному исследованию магнитных систем со случайным взаимодействием. Как показали Имри и

Магнитное поле в таких системах существенным образом меняет состояние магнетика при $T < T_N$. Один из способов создания подобных систем был предложен Фишманом и Ахарони². Авторами работы² было показано, что если анизотропный изинговский антиферромагнетик, разбавленный немагнитными примесями, поместить в постоянное и однородное магнитное поле, направленное вдоль легкой оси, то оно будет действовать аналогично случайному магнитному полю на неразбавленный ферромагнетик. Так как число магнитных ионов в каждой подрешетке меняется вдоль образца, то должен флюктуировать и суммарный магнитный момент. При приложении внешнего магнитного поля возникает конкуренция между антиферромагнитным упорядочением спинов и разбиением системы на области с суммарным моментом, повернутым по H . Таким образом магнитное поле приводит, в частности, к разрушению дальнего порядка при $T < T_N$.

Нами проводились измерения интенсивности дифракционных максимумов, соответствующих упругому рассеянию нейтронов от плоскостей (100) и (200) моноокристалла $Mn_{0.5}Zn_{0.5}F_2$ в зависимости от температуры в отсутствии магнитного поля и в поле 20 кЭ, параллельном оси C_4 . Указанная концентрация Mn и Zn соответствует относительному молярному содержанию исходных компонентов при выращивании моноокристаллов. Кристаллическая структура MnF_2 такова, что отражение (100) является чисто магнитным. Измерения проводились методом времени пролета на дифрактометре, созданном на базе микротрона ИФП АН СССР³, под углом брэгговского отражения 90° . Образец размером $12 \times 7 \times 3$ мм помещался в вакуумной полости внутри гелиевого криостата и нагревался с помощью токовых катушек, навитых на алюминиевый держатель кристалла. Поле создавалось сверхпроводящими катушками Гельмгольца и было направлено вдоль тетрагональной оси кристалла. Время измерения каждой точки составляло ~ 30 мин, стабильность температуры 0,1 К.



Температурная зависимость интенсивности магнитного отражения от плоскостей (100) при $H = 0$ и 20 кЭ. Пунктиром на кривой при $H = 20$ кЭ показана зависимость $I_{100}(T)$ при $H = 0$

На рисунке показаны зависимости от температуры относительной интенсивности магнитного отражения от плоскости (100). Нормировка проводилась по монитору нейтронного потока. Вклад некогерентного рассеяния оценивался по результатам измерений в области выше T_N . Величина ошибки определяется практически только статистикой отсчетов. Сплошные линии проведены от руки в среднем по экспериментальным точкам. Эти кривые не соответствуют температурной зависимости намагниченности подрешеток, то есть $I_{(100)}$ не пропорционально $M^2(T)$. Аналогичные расхождения наблюдались нами и в неразбавленном MnF_2 и объясняются большой величиной экстинкции. Уменьшение примерно в 2 раза абсолютного значения интенсивности отражения в магнитном поле связано скорее всего с неконтролируемым поворотом кристалла в поле ($\sim 0.5^\circ$), так как во столько же раз уменьшается в поле и интенсивность ядерного отражения от плоскости (200), наблюдавшегося под тем же брэгговским

углом. В пределах ошибки кривые повторяют друг друга при $T < 20$ К. Выше этой температуры интенсивность отражения от кристалла в магнитном поле спадает быстрее и обращается в ноль на $1,3 \pm 0,3$ К ниже. В неразбавленном MnF_2 в том же поле температурный сдвиг $\Delta T = 0,06$ К⁵ и если его считать пропорциональным концентрации магнитных ионов, т.е. $\Delta T = Bh^2 \sim x(H/T)^2$, то в нашем кристалле он должен составлять примерно 0,19 К, что значительно ниже экспериментально наблюдаемой величины. Величина T_N в нулевом поле для исследуемого кристалла равна 27,4 К. Если предположить, что зависимость T_N от концентрации x ионов Zn определяется выражением $T_N(x) = 1,25 T_N(0) (x - 0,2)$, с которой согласуется ряд экспериментальных результатов⁴, то мы получаем для нашего кристалла значение $x = 0,53$, хорошо совпадающее с исходной концентрацией компонент. Таким образом, действию хаотического магнитного поля можно приписать сдвиг ΔT на 1,1 К. Аналогичные экспериментальные результаты были получены недавно в работе⁵, в которой исследовалась зависимость от магнитного поля показателя преломления света в кристаллах $\text{Mn}_{1-x}\text{Zn}_x\text{F}_2$ ($x = 0,2$ и $0,35$).

Согласно² хаотическое магнитное поле, характеризуемое приведенным полем $h = \mu H/kT$, где $\mu = \mu_B g S$, приводит к разрушению дальнего порядка при

$$T_c = T_N - B h^2 - T_N(A h^2 / U_0)^{1/\phi},$$

где в соответствие с работой⁵ $A \cong x/(1-x)/(zJ/kT)^2$, а Bh^2 – сдвиг температуры перехода в магнитном поле, присутствующий и в неразбавленном MnF_2 . Для сравнения наших результатов с предсказаниями теоретических расчетов, мы воспользовались результатами экспериментов⁵, в которых при $H = 20$ кЭ $\Delta T = 0,35$ и 0,81 К для $x = 0,2$ и $0,35$ соответственно и определено значение критического индекса $\phi = 1,4$. Исходя из этих данных при $x = 0,5$ сдвиг температуры перехода должен составлять $T_c - T_N = 1,4 \div 1,53$ К, что согласуется с полученной нами величиной.

Следует отметить, что в работах^{6,7} также проводились нейтронографические исследования разбавленных растворов $\text{Mn}_{1-x}\text{Zn}_x\text{F}_2$. В этих работах приложении поля вдоль оси легкого намагничивания отмечалось уширение дифракционных пиков, свидетельствующее об уменьшении корреляционной длины. В наших экспериментах разрешение было примерно на два порядка хуже, чем в⁶, что не позволяло нам делать по этому поводу каких-либо заключений.

Таким образом, имеющиеся к настоящему времени данные свидетельствуют в пользу теоретических предсказаний о характере влияния магнитного поля на поведение разбавленных антиферромагнетиков. Следует однако подчеркнуть, что по теоретическим предсказаниям хаотическое магнитное поле должно приводить к разрушению дальнего порядка при всех температурах ниже T_N . Экспериментальная ситуация остается неопределенной. Так, например, результаты работы^{6,7} показывают, что при охлаждении $\text{Co}_{1-x}\text{Zn}_x\text{F}_2$ в присутствии магнитного поля образуется необычное состояние без дальнего порядка, однако это состояние может оказаться метастабильным. Весьма интересны исследования состояния сильно разбавленных систем, когда примесь уже нельзя считать малой. В частности, в работе⁸ вблизи критической концентрации примеси наблюдалось аномальное поведение χ_L в сильном магнитном поле.

Авторы глубоко признательны П.Л.Капице, С.П.Капице за поддержку исследований, А.С.Боровику-Романову за постоянное обсуждение работы, А.Н.Бажану за помощь в наладке низкотемпературной аппаратуры, С.В.Петрову за предоставленные образцы кристаллов и Б.С.Закирову за помощь в техническом обслуживании ускорителя.

Литература

1. Ymry Y., Ma S. Phys. Rev. Lett., 1975, 35, 1399.

2. Fishman S., Aharony A. J. Phys., 1979, C12, L729.
3. Бажан А.Н., Закиров Б.С., Зыкин Л.М., Капица С.П., Ципенюк Ю.М. Нейтронная физика, ч.4, М. 564. ЦНИИатоминформ, 1980, с. 76.
4. Belanger D.P., Borsa F., King A.R., Jaccarino V. J. Magn.Magn.Mater., 1980, 15 -18, 807.
5. Belanger D.P., King A.R., Jaccarino V. Phys. Rev. Lett., 1982, 48, 1050.
6. Yoshizawa H., Cowley R.A., Shirane Y., Birgeneau R.I., Guggenheim H.G., Ikeda H. Phys. Rev. Lett., 1982, 48, 438
7. Cowley R.A. J. Magn.Magn.Mater., 1983, 31 -34, 1439.
8. Borovik-Romanov A.S., Bazhan A.N., Ali Ya Amin, Petrov S.V. J. Magn.Magn. Mater., 1983, 31 -34, 1121.

Институт физических проблем
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
12 апреля 1983 г.